



1741
SAD
#2
9-20-01

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: Ryushin Omasa

Serial No.: 09/864,650

Group: 1741

Filed: May 23, 2001

Examiner: ~~Not Yet Assigned~~ *Leader*

For: ELECTROPLATING METHOD USING COMBINATION OF
VIBRATIONAL FLOW IN PLATING BATH AND PLATING CURRENT OF PULSE

711 Third Avenue
New York, New York 10017
212-687-6000

TRANSMITTAL OF PRIORITY DOCUMENTS

Assistant Commissioner
for Patents
Washington, D.C. 20231

RECEIVED
AUG 07 2001
TC 1700

S I R:

Enclosed herewith is a certified copy of each of the following Japanese patent applications: 2000-155046 filed May 25, 2000; 2000-243249 filed August 10, 2000; and 2001-129994 filed April 26, 2001 which have all been claimed as priority in the above referenced patent application.

Certificate of Mailing
I hereby certify that this correspondence is, on the date shown below being deposited with the United States Postal Service with sufficient postage as first class mail in an envelope addressed: Assistant Commissioner for Patents, Washington, D. C. 20231 on August 1, 2001

Ronald R. Santucci
Attorney
Ronald R. Santucci
Signature
August 1, 2001
Date of Signature

The Commissioner is hereby authorized to charge any additional fees which may be required, or credit any overpayment to Account No. 501145, Order No. 2343-128.

Respectfully submitted,


Ronald R. Santucci

Registration No. 28,988

(212) 687-6000
Pitney, Hardin, Kipp & Szuch, LLP
711 Third Avenue, 20th Floor
New York, New York 10017

RECEIVED
AUG 07 2007
TC 1700



This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office

2000年 5月25日

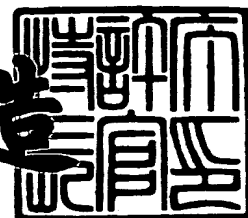
特願 2 0 0 0 - 1 5 5 0 4 6

日本テクノ株式会社

RECEIVED
AUG 07 2007
TC 1700

2001年 5月11日

及川耕造



出証番号 出証特2001-3039993

【書類名】 特許願

【整理番号】 D-15982

【提出日】 平成12年 5月25日

【あて先】 特許庁長官殿

【国際特許分類】 C25D 5/00

【発明者】

 【住所又は居所】 神奈川県藤沢市片瀬山5丁目28番11号

 【氏名】 大政 龍晋

【特許出願人】

 【識別番号】 392026224

 【氏名又は名称】 日本テクノ株式会社

【代理人】

 【識別番号】 100065385

 【弁理士】

 【氏名又は名称】 山下 穰平

 【電話番号】 03-3431-1831

【手数料の表示】

 【予納台帳番号】 010700

 【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

 【物件名】 明細書 1

 【物件名】 図面 1

 【物件名】 要約書 1

【ブルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 めっき浴の振動流動とパルス状めっき電流との組み合わせを用いた電解めっき方法

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 めっき浴内に配置された振動羽根を振動させることにより前記めっき浴に振動流動を発生させながら、前記めっき浴と接触するように配置された被めっき物品を陰極とし且つ前記めっき浴と接触するように配置された金属部材を陽極とし、前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加し、この際に前記陽極から前記めっき浴を介して前記陰極へと流れるめっき電流が第 1 の値 I_1 で第 1 の時間 T_1 持続する第 1 状態及び前記第 1 の値と同一極性の第 2 の値 I_2 で第 2 の時間 T_2 持続する第 2 状態を交互にとり、前記第 1 の値 I_1 は前記第 2 の値 I_2 の 6 倍以上であり、前記第 1 の時間 T_1 は前記第 2 の時間 T_2 の 4 倍以上であることを特徴とする電解めっき方法。

【請求項 2】 前記第 1 の値 I_1 は前記第 2 の値 I_2 の 8 ～ 20 倍であり、前記第 1 の時間 T_1 は前記第 2 の時間 T_2 の 6 ～ 20 倍であることを特徴とする、請求項 1 に記載の電解めっき方法。

【請求項 3】 前記振動羽根は振幅 0.1 ～ 10.0 mm 及び振動数 200 ～ 800 回/分で振動せしめられることを特徴とする、請求項 1 ～ 2 のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項 4】 前記めっき浴の振動流動は 3 次元流速が 150 mm/秒以上であることを特徴とする、請求項 1 ～ 3 のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項 5】 前記振動羽根は振動発生手段に係して前記めっき浴内で振動する振動棒に一段または多段に固定されており、前記振動発生手段は 10 ～ 500 Hz で振動することを特徴とする、請求項 1 ～ 4 のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項 6】 前記被めっき物品を振幅 0.1 ～ 5.0 mm 及び振動数 100 ～ 300 回/分で振動させることを特徴とする、請求項 1 ～ 5 のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項 7】 前記被めっき物品を揺動幅 10 ～ 100 mm 及び揺動数 10

～30回／分で揺動させることを特徴とする、請求項1～6のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項8】 前記被めっき物品は寸法50 μ m以下の微細構造をもつ被めっき面を有することを特徴とする、請求項1～7のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項9】 複数の前記被めっき物品を、めっき浴の液体が通過し得る小開口を有し且つ前記被めっき物品と接触することで該被めっき物品にめっき電流を流すための導電部材を有する保持容器中に保持し、該保持容器を前記めっき浴中で非鉛直方向の回転中心の周りで回転させることで前記複数の被めっき物品を前記保持容器内で転動させ、前記被めっき物品のそれぞれと前記導電部材との接触及び離隔を繰り返すことを特徴とする、請求項1～8のいずれかに記載の電解めっき方法。

【請求項10】 前記被めっき物品の幅は5mm以下であることを特徴とする、請求項9に記載の電解めっき方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】

本発明は、めっき方法に関するものであり、特にめっき浴の物理的条件とめっき電流の電氣的条件との特定の組み合わせに特徴を有するめっき方法に関するものである。

【0002】

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】

従来、電子部品などの物品の製造の分野において、物品の表面に導電材料の膜を形成する電解めっきが広く利用されている。

【0003】

特に、最近では電子部品の小型化及び高機能化の要求を満たすために、物品の表面（スルーホールの内面やブラインドビアホールの内面を含む）に形成される導電パターンとして微細なものが要求されている。

【0004】

例えば、半導体装置の高集積化に伴う入出力端子の狭ピッチ化に対応して配線パターンの微細化が進められており、これに伴いスルーホールやブラインドビアホールの内径として $100\mu\text{m}$ 以下更には $50\mu\text{m}$ 以下更には $30\mu\text{m}$ 以下と小さなものが要求されている。また、スルーホールやブラインドビアホールのアスペクト比も5以上更には8以上と大きなものが要求されている。

【0005】

また、例えば、半導体装置における多層配線では、高集積化に伴う配線微細化に起因して発生する配線間容量の低減を目的として、従来のアルミニウム配線に代わって銅配線が利用されており、そのような多層配線の形成のために電解めっきを用いたダマシン法が利用されている。この方法では、内径 $1\mu\text{m}$ 以下と極小さなブラインドビアホール内への銅の堆積が要求されている。

【0006】

また、例えば、 0.3mm 程度の寸法のチップ部品の表面に1対の電極膜を形成することが要求されている。

【0007】

ところで、本出願人は、特に微細孔などの微細構造部分を有する物品に適用して有効なめっき方法を提案している（特開平11-189880号公報参照）。この方法では、めっき浴に振動流動を発生させ、これと散気管によるバブリングとを併用している。この方法は電解めっき以外に無電解めっきに適用しても有効なものである。

【0008】

しかしながら、この方法では、めっき浴を収容するめっき槽内に散気管を配置し、該散気管へのエア配管することが必要であるので、めっき浴の量及びめっき槽の寸法を比較的大きくしなければならないなど、めっき装置が大型化するという難点があった。

【0009】

一方、以上のような電解めっきのための電源としては、一般的には直流電源が用いられている。ところで、近年、めっき膜の品質を向上させるために、めっき電流を周期的に変化させながらめっきを行うことが提案されている。この方法では

、正極性の電流と負極性の電流とを交互に流す。即ち、正極性通電で一旦形成しためっき膜の表面の微小凹凸のうちの凸部を、負極性通電により集中して部分的に溶解させ、これを繰り返すことにより表面が平坦で微小空洞などの欠陥のない高品質のめっき膜を得ることを目指している。しかし、この方法では一旦形成しためっき膜の表面部を除去するので成膜速度の向上（即ち、めっき処理速度の向上）の点では不利である。

【 0 0 1 0 】

最近では、導電パターンはますます微細化する傾向にあり、そのような導電パターンのめっき膜を形成する際には、欠陥や膜厚不均一性が発生しやすくなり、めっき膜の良好な品質の維持が次第に困難になってくる。

【 0 0 1 1 】

また、本出願人は、めっき浴を振動攪拌しながらクロムめっきを行うめっき方法及び多数の被めっき物品をバレルに収容してめっき浴を振動攪拌しながらクロムめっきを行う方法を提案している（特開平 7 - 5 4 1 9 2 号公報及び特開平 6 - 3 3 0 3 9 5 号公報参照）。

【 0 0 1 2 】

しかしながら、これらの方法ではめっき電流として直流電源が用いられており、また長手方向を横切る方向の寸法即ち幅が 5 mm 以下例えば 0. 3 ~ 1. 0 mm といった微小寸法の被めっき物品への適用については具体的には示されていない。このような微小寸法の被めっき物品のバレルめっきにおいては、バレル内で被めっき物品どうしが重なり合って所要のめっき膜形成部分へのめっき液の流通性が極端に低下する。このため、比較的大きな幅の被めっき物品の場合とは比較にならないような技術的困難性があり、成膜速度及びめっき膜厚均一性の点で更なる改良の余地がある。

【 0 0 1 3 】

そこで、本発明の目的の 1 つは、微細構造の導電パターンのめっき膜を欠陥や膜厚不均一性などがなく良好な品質で形成することが可能なめっき方法を提供することにある。

【 0 0 1 4 】

本発明の他の目的は、微細構造の導電パターンの良好な品質のめっき膜を高速に得ることが可能なめっき方法を提供することにある。

【0015】

本発明の更に別の目的は、微細構造の導電パターンの良好な品質のめっき膜を比較的小さな装置構成で効率よく得ることが可能なめっき方法を提供することにある。

【0016】

【課題を解決するための手段】

本発明によれば、上記目的を達成するものとして、

めっき浴内に配置された振動羽根を振動させることにより前記めっき浴に振動流動を発生させながら、前記めっき浴と接触するように配置された被めっき物品を陰極とし且つ前記めっき浴と接触するように配置された金属部材を陽極とし、前記陰極と前記陽極との間に電圧を印加し、この際に前記陽極から前記めっき浴を介して前記陰極へと流れるめっき電流が第1の値 I_1 で第1の時間 T_1 持続する第1状態及び前記第1の値と同一極性の第2の値 I_2 で第2の時間 T_2 持続する第2状態を交互にとり、前記第1の値 I_1 は前記第2の値 I_2 の6倍以上であり、前記第1の時間 T_1 は前記第2の時間 T_2 の4倍以上であることを特徴とする電解めっき方法、
が提供される。

【0017】

本発明の一態様においては、前記第1の値 I_1 は前記第2の値 I_2 の8～20倍であり、前記第1の時間 T_1 は前記第2の時間 T_2 の6～20倍である。本発明の一態様においては、前記振動羽根は振幅0.1～10.0mm及び振動数200～800回/分で振動せしめられる。本発明の一態様においては、前記めっき浴の振動流動は3次元流速が150mm/秒以上である。本発明の一態様においては、前記振動羽根は振動発生手段に連係して前記めっき浴内で振動する振動棒に一段または多段に固定されており、前記振動発生手段は10～500Hzで振動する。

【0018】

本発明の一態様においては、前記被めっき物品を振幅 0.1 ～ 5.0 mm 及び振動数 100 ～ 300 回/分で振動させる。本発明の一態様においては、前記被めっき物品を揺動幅 10 ～ 100 mm 及び揺動数 10 ～ 30 回/分で揺動させる。

【0019】

本発明の一態様においては、前記被めっき物品は寸法 50 μ m 以下の微細構造をもつ被めっき面を有する。

【0020】

本発明の一態様においては、複数の前記被めっき物品を、めっき浴の液体が通過し得る小開口を有し且つ前記被めっき物品と接触することで該被めっき物品にめっき電流を流すための導電部材を有する保持容器中に保持し、該保持容器を前記めっき浴中で非鉛直方向の回転中心の周りで回転させることで前記複数の被めっき物品を前記保持容器内で転動させ、前記被めっき物品のそれぞれと前記導電部材との接触及び離隔を繰り返す。

【0021】

本発明の一態様においては、前記被めっき物品の幅は 5 mm 以下である。

【0022】

【発明の実施の形態】

以下、図面を参照しながら本発明の具体的な実施の形態を説明する。尚、図面において、同様な機能を有する部材又は部分には同一の符号が付されている。

【0023】

図 1 及び図 2 は本発明によるめっき方法の第 1 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図であり、図 3 はその平面図である。

【0024】

これらの図において、12 はめっき槽であり、該めっき槽にはめっき浴 14 が収容されている。16 は振動流動発生部である。該振動流動発生部 16 は、めっき槽 12 に防振ゴムを介して取り付けられた基台 16a、該基台に下端を固定された振動吸収部材としてのコイルバネ 16b、該コイルバネの上端に固定された振動部材 16c、該振動部材に取り付けられた振動発生手段としての振動モータ

1 6 d、振動部材 1 6 c に上端を取り付けられた振動伝達ロッド 1 6 e、該振動伝達ロッドの下半部においてめっき浴 1 4 に浸漬する位置に取り付けられた振動羽根 1 6 f を有する。

【 0 0 2 5 】

振動モータ 1 6 d は例えばインバータを用いた制御により 1 0 ～ 5 0 0 H z、好ましくは 2 0 ～ 6 0 H z、更に好ましくは 3 0 ～ 5 0 H z で振動する。振動モータ 1 6 d で発生した振動は、振動部材 1 6 c 及び振動伝達ロッド 1 6 e を介して振動羽根 1 6 f に伝達される。振動羽根 1 6 f は、めっき浴 1 4 中で所要の振動数で先端縁が振動する。この振動は、振動羽根 1 6 f が振動伝達ロッド 1 6 e への取り付け部分から先端縁へと「しなる」ように発生する。この振動の振幅及び振動数は、振動モータ 1 6 d のものとは異なるが、振動伝達経路の力学的特性及びめっき浴 1 4 との相互作用の特性などに応じて決まり、本発明では振幅 0 . 1 ～ 1 0 . 0 m m で振動数 2 0 0 ～ 8 0 0 回 / 分とするのが好ましい。

【 0 0 2 6 】

図 4 は振動部材 1 6 c への振動伝達ロッド 1 6 e の取り付け部の拡大断面図である。振動伝達ロッド 1 6 e の上端に形成されたオネジ部に、振動部材 1 6 c の上下両側から振動応力分散部材 1 6 g 1、1 6 g 2 及びワッシャ 1 6 h 1、1 6 h 2 を介してナット 1 6 i 1、1 6 i 2 ; 1 6 i 3、1 6 i 4 を適合させている。振動応力分散部材 1 6 g 1、1 6 g 2 は、例えばゴムからなる。

【 0 0 2 7 】

図 5 は振動伝達ロッド 1 6 e への振動羽根 1 6 f の取り付け部の拡大断面図である。7 つの振動羽根 1 6 f の各々の上下両側には、振動羽根固定部材 1 6 j が配置されている。隣接する振動羽根 1 6 f どうしの間には固定部材 1 6 j を介して振動羽根 1 6 f の間隔設定のためのスペーサリング 1 6 k が配置されている。最上部の振動羽根 1 6 f の上側及び最下部の振動羽根 1 6 f の下側には、振動伝達ロッド 1 6 e に形成されたオネジに適合するナット 1 6 m が配置されている。

【 0 0 2 8 】

図 6 は振動伝達ロッド 1 6 e への振動羽根 1 6 f の取り付け部の変形例を示す図である。この変形例では、各振動羽根 1 6 f を上側及び下側のナット 1 6 n に

より個別に振動伝達ロッド 1 6 e へ取り付けられている。尚、振動羽根 1 6 f と固定部材 1 6 j との間にフッ素系樹脂やフッ素系ゴムなどからなる弾性部材シート 1 6 p を介在させることで、振動羽根 1 6 f の破損を防止することができる。図示されているように、上側の固定部材 1 6 j の下面（押圧面）は凸円筒円とされており、下側の固定部材 1 6 j の上面（押圧面）は対応する凹円筒円とされている。これにより、固定部材 1 6 j により上下方向から押圧される振動羽根 1 6 f の部分は湾曲せしめられ、振動羽根 1 6 f の先端部は水平面に対して角度 α をなしている。この角度 α は、例えば -30° 以上 30° 以下好ましくは -20° 以上 20° 以下とすることができる。特に、角度 α は、 -30° 以上 -5° 以下または 5° 以上 30° 以下、好ましくは -20° 以上 -10° 以下または 10° 以上 20° 以下とするのが好ましい。固定部材 1 6 j の押圧面を平面とした場合には、角度 α は 0° である。角度 α は、全ての振動羽根 1 6 f について同一である必要はなく、例えば図 1 に示されているように、下方の 1 ～ 2 枚の振動羽根 1 6 f については $-$ の値（即ち下向き：図 6 に示されるものと逆向き）とし、それ以外の振動羽根 1 6 f については $+$ の値（即ち上向き：図 6 に示される向き）とすることができる。

【 0 0 2 9 】

振動羽根 1 6 f としては、弾力性のある金属板、合成樹脂板またはゴム板などを用いることができる。振動羽根 1 6 f の厚みは、振動流動発生部 1 6 の作動時に、振動羽根 1 6 f の先端縁部分がフラッター現象（波打つような状態）を呈するように設定される。振動羽根 1 6 f がステンレス鋼板などの金属板からなる場合には、その厚みは $0.2 \sim 2 \text{ mm}$ とすることができる。また、振動羽根 1 6 f が合成樹脂板やゴム板からなる場合には、その厚みは $0.5 \sim 10 \text{ mm}$ とすることができる。

【 0 0 3 0 】

図 1 ～ 3 において、揺動モータ 2 0 は連結ロッド 2 2 を介して揺動フレーム 2 4 と接続されている。該揺動フレーム 2 4 は、レール 2 6 上にて水平方向（図 1 における左右方向）に往復移動可能なように配置されている。揺動フレーム 2 4 には振動モータ 2 8 が取り付けられている。揺動フレーム 2 4 には、また、陰極

ブスバー 30 及び陽極ブスバー 32 が揺動フレーム 24 との絶縁状態を維持して取り付けられており、これらはそれぞれ電源回路 34 の負極端子及び正極端子に接続されている。電源回路 34 は交流電圧から矩形波状電圧を作成することができるものであり、このような電源回路は例えばトランジスタを用いた整流回路を有するものであり、パルス電源装置として知られている。

【0031】

本発明でめっき電流を発生させるのに使用される電源回路（電源装置）としては、交流を整流（直流成分の付加を含む）して出力するものが用いられる。このような電源装置または整流器としては、トランジスタ調整式電源、ドロップ方式の電源、スイッチング電源、シリコン整流器、SCR 型整流器、高周波型整流器、インバータデジタル制御方式の整流器（例えば（株）中央製作所製の Power Master）、（株）三社電機製作所製の KTS シリーズ、四国電機株式会社製の RCV 電源、スイッチングレギュレータ式電源とトランジスタスイッチとからなりトランジスタスイッチが ON-OFF することで矩形波状のパルス電流を供給するもの、高周波スイッチング電源（交流をダイオードにて直流に変換した後にパワートランジスタで 20～30 KHz の高周波をトランスに加えて再度整流、平滑化し出力を取り出す）、PR 式整流器、高周波制御方式の高速パルス PR 電源（例えば Hi PR シリーズ（（株）千代田）などが利用可能である。

【0032】

陰極ブスバー 30 には被めっき物品 X の保持のための導電性の保持部材 40 の上部が機械的及び電氣的に接続されている。被めっき物品保持部材 40 の下部はめっき浴 14 中に浸漬されており、この部分に被めっき物品 X が電氣的に接続されて保持されている。なお、図には示されていないが、陽極ブスバー 32 にはめっきされる金属からなる陽極金属部材（例えばプラスチック製の籠に收容された形態）が機械的及び電氣的に接続されており、その下部はめっき浴 14 中に浸漬されている。尚、陰極ブスバーへの被めっき物品の取り付け及び陽極ブスバーへの陽極金属部材の取り付け方法や、陰極ブスバー及び陽極ブスバーの形状及び構造としては、従来知られている種々のものを使用することができる。

【0033】

図7は被めっき物品の陰極ブスバーへの取り付けの変形例を示す断面図である。この例では、導電性の保持部材40として、陰極ブスバー30へ取り付けられる上部のフック部40aと、被めっき物品Xを挟持する下部のクランプ部40bと、該クランプ部のクランプ力を発生する圧縮バネ40cとを有する。

【0034】

図1～3において、揺動モーター20を作動させることにより、揺動フレーム24及び保持部材40ひいてはこれに取り付けられた被めっき物品Xは例えば揺動幅10～100mm及び揺動数10～30回/分で揺動せしめられる。また、振動モータ28は例えばインバータを用いた制御により10～60Hz、好ましくは20～35Hzで振動する。振動モータ28で発生した振動は、揺動フレーム24及び保持部材40を介して被めっき物品Xに伝達され、これにより被めっき物品Xは振幅0.1～5.0mmで振動数100～300回/分で振動せしめられる。

【0035】

図8は電源回路34により陰極ブスバー30と陽極ブスバー32との間に印加される電圧に基づき被めっき物品Xを介して流れるめっき電流（電流密度）の変化を示すグラフである。図示されているように、めっき電流は、第1の値I1で第1の時間T1持続する第1状態と第2の値I2（ $I_2 < I_1$ ）で第2の時間T2持続する第2状態とが交互にあらわれるようなものである。ここで、第1の値I1と第2の値I2とは同一極性である。I1はI2の6倍以上であり好ましくは8～20倍である。また、T1はT2の4倍以上好ましくは6～20倍である。このようなめっき電流と上記振動流動発生部16によるめっき浴14の振動流動を組み合わせることにより、微細な導電構造パターンのめっきにおいても良好な品質及び高い成膜速度を得ることができる。

【0036】

第1の値I1及び第1の時間T1は、めっきの種類（例えば、硫酸銅めっき、シアン化銅めっき、ピロリン酸銅めっき、ニッケルめっき、黒色ニッケルめっき、スルファミン酸ニッケルめっき、クロムめっき、シアン化亜鉛めっき、ノーシア

ン亜鉛めっき、アルカリ性スズめっき、酸性スズめっき、銀めっき、シアン化金めっき、酸性金めっき、銅-亜鉛合金めっき、ニッケル-鉄合金めっき、スズ-鉛合金めっき、パラジウムめっき、はんだめっき等)あるいはめっき浴の組成などに応じて適宜設定されるが、例えば、 I_1 は $0.01 \sim 100 [A/dm^2]$ の範囲内とすることができ、 T_1 は $3 \sim 300$ [秒]の範囲内とすることができる。但し、これに限定されるものではなく、最適な I_1 , I_2 , T_1 , T_2 は、上記めっきの種類やめっき浴の組成などに応じて広い範囲で変化することもあり、例えばめっきの進行に伴いめっき浴の組成が変化することで変化したりする。

【0037】

めっき浴14は、形成すべきめっき膜に応じて、公知の電解めっき法と同様にして、選択される。例えば、硫酸銅めっきを行う場合には、スルーホール浴として、

硫酸銅： 60～100 g/L (リットル)

硫酸： 170～210 g/L

光沢剤： 適量

塩素イオン： 30～80 mL/L

からなるものを用いることができ、普通浴として、

硫酸銅： 180～250 g/L

硫酸： 45～60 g/L

光沢剤： 適量

塩素イオン： 20～80 mL/L

からなるものを用いることができる。

【0038】

また、例えば、ニッケルめっきを行う場合には、バレル浴として、

硫酸ニッケル： 270 g/L

塩化ニッケル： 68 g/L

ほう酸： 40 g/L

硫酸マグネシウム： 225 g/L

からなるものを用いることができ、普通浴として、

硫酸ニッケル： 1 5 0 g / L

塩化アンモニウム： 1 5 g / L

ほう酸： 1 5 g / L

からなるものを用いることができる。

【 0 0 3 9 】

また、例えば、酸性スズめっきを行う場合には、硫酸塩浴として、

硫酸第一スズ： 5 0 g / L

硫酸： 1 0 0 g / L

クレゾールスルホン酸： 1 0 0 g / L

ゼラチン： 2 g / L

β -ナフトール： 1 g / L

からなるものを用いることができる。

【 0 0 4 0 】

被めっき物品Xとしては、特に限定されないが、本発明の特長が顕著に発揮されるのは、微細構造を有するめっき膜を形成する場合であり、この様な被めっき物品のめっきの例としては、多層配線基板の内径 2 0 ~ 1 0 0 μ m 程度（特に 5 0 μ m 以下、更には 3 0 μ m 以下）の微小なスルーホールやブラインドビアホールの内面上へのめっき導電膜の形成；配線基板のピッチ 2 0 ~ 5 0 μ m 程度（特に 3 0 μ m 以下）の高密度配線パターンのための微小溝内での導電膜の形成；半導体装置の多層配線形成の際の銅ダマシン法での内径 0. 3 μ m 程度の極微小なブラインドビアホールへの埋め込み導電膜の形成；半導体装置の高密度配置の微小電極バンプの形成；などが例示される。特に、本発明は、高アスペクト比の構造に適用した場合の改善効果大きい。

【 0 0 4 1 】

本発明のめっき方法では、振動流動発生部 1 6 によりめっき浴 1 2 に生ぜしめられる振動流動により微細構造の凹部内へのめっき浴の流通性が改善されると共に、めっき電流密度を第 1 状態と該第 1 状態より十分に低いけれども同一極性の値で且つ第 1 状態より十分に短い時間の第 2 状態との繰り返しからなるものとしたことで、膜厚均一性を高めることができ、ガスピット等の欠陥発生を低減する

ことができ、高い表面光沢を得ることが可能となり、また、高い成膜速度を得ることができ、製造装置構成を簡単化することができる。従って、広範な被めっき物品について、高い良品率で効率よく高速で所望のめっき膜を形成することができる。

【 0 0 4 2 】

この様な作用を良好に得るためには、めっき浴 1 4 の振動流動の 3 次元流速が 1 5 0 m m / 秒以上であるのが極めて好ましい。このような高い 3 次元流速は、めっき浴を振動流動させることによって効果的に実現されるものであり、通常の攪拌によっては実現困難であり実現するにしても極めて大規模な装置構成が必要となる不利がある。

【 0 0 4 3 】

本実施形態では、揺動フレーム 2 4 の揺動及び／または振動による被めっき物品 X の揺動及び／または振動を行うことにより上記効果の一層の向上がなされるが、これら被めっき物品 X の揺動及び振動を行わなくとも良好な効果は得られる。揺動フレーム 2 4 、揺動モータ 2 0 及び振動モータ 2 8 等を使用することなく陰極ブスパー 3 0 、陽極ブスパー 3 2 、被めっき物品 X 及び陽極金属部材等を支持することで、装置構成が一層簡単化される。

【 0 0 4 4 】

図 9 及び図 1 0 は本発明によるめっき方法の第 2 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図であり、図 1 1 はその平面図である。

【 0 0 4 5 】

この実施形態は、被めっき物品 X の保持及び該被めっき物品への給電の様式が上記図 1 ～ 8 に関し説明した第 1 の実施形態のものと異なり、所謂バレルめっき方式を採用したものである。

【 0 0 4 6 】

図 9 ～ 1 1 において、振動フレーム 4 4 が振動吸収部材としてのコイルバネ 4 6 を介してめっき槽 1 2 に取り付けられている。振動フレーム 4 4 には、振動モータ 4 8 及びこれとの重量バランスをとるためのバランスウェイト 4 9 とが取り付けられている。振動フレーム 4 4 には、支持部材 5 0 を介してバレル 5 2 が取

り付けられている。該バレルは、支持部材 5 0 に対して回転可能に取り付けられており、不図示の駆動手段により図 9 において矢印で示される向きに回転せしめられる。バレル 5 2 内には微小な被めっき物品 X が多数収容されている。バレル 5 2 の外周面には、被めっき物品 X の通過を阻止し且つめっき浴 1 2 の液体の通過を許容する多数の小開口が形成されている。バレル 5 2 内にはその下部にまで延びた陰極導電部材 5 4 が配置されている。該陰極導電部材 5 4 は、バレル 5 2 の回転中心にて該バレルに取り付けられたパイプ部材 5 2 a 内を通過して電源回路 3 4 の負極端子に接続されている。陰極導電部材 5 4 は、バレル回転の際にも回転することではなく、従ってバレル回転に伴い転動する被めっき物品 X は陰極導電部材 5 4 との接触及び陰極部材 5 4 からの離隔を繰り返す。5 6 はメッキ浴 1 4 中に下部が浸漬された陽極金属部材である。該陽極金属部材 5 6 は、電源回路 3 4 の正極端子に接続されている。

【 0 0 4 7 】

振動モータ 4 8 は、例えば上記の振動モータ 2 8 と同程度の振幅及び振動数で振動し、被めっき物品 X は振幅 0. 1 ~ 5. 0 mm で振動数 1 0 0 ~ 3 0 0 回 / 分で振動せしめられる。本実施形態でも、振動フレーム 4 4 の振動による被めっき物品 X の振動を行うことにより効果の一層の向上がなされるが、この被めっき物品 X の振動を行わなくとも良好な効果は得られる。振動フレーム 4 4 及び振動モータ 4 8 等を使用することなく支持部材 5 0 及びバレル 5 2 を支持することで、装置構成が一層簡単化される。

【 0 0 4 8 】

本実施形態において、めっき電流密度は上記図 8 に関し説明したと同様に設定される。本実施形態では、被めっき物品 X の各々には、陰極導電部材 5 4 との各接触時には、第 1 状態または第 2 状態或は第 1 状態と第 2 状態との間で変化する過程のめっき電流が流されるが、接触時の電流密度のみを連続して表示すれば、平均的には、図 8 に示されている様になり、やはり上記第 1 の実施形態と同様な効果が得られる。

【 0 0 4 9 】

本実施形態は、特に微小寸法の被めっき物品 X たとえば 0. 6 mm × 0. 3 mm

m×0.2mm程度の寸法のセラミックチップコンデンサ等のチップ部品における電極膜の形成や直径0.5mm×長さ20mm程度のピンにおけるめっき膜の形成などを多数の被めっき物品Xについて同時に行う場合に好適である。このように、被めっき物品として長手方向を横切る方向の寸法即ち幅が5mm以下、なかでも2mm以下、そのなかでも1mm以下といった微小なものを用いる場合には、めっき膜厚の均一性及び成膜速度の点での改善効果が大きい。

【0050】

本発明による電解めっき方法の実施に先立ち、所要の前処理工程を行うことはもちろんである。これら前処理については、従来公知の電解めっき方法の場合と同様にして行えばよい。

【0051】

また、本発明方法においてめっき浴中に所要の振動流動を発生させるのに使用される振動羽根を備えた振動流動発生部としては、上記特開平11-189880号公報に記載のものや該公報中にて引用されている公報に記載されているものを適宜使用することができる。

【0052】

図12は本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置の他の形態を示す断面図であり、図13はその一部切欠平面図である。この形態は、振動流動発生部16の構成が上記実施形態と異なる。即ち、めっき槽12の上端縁部に固定された取り付け部材118に対してコイルバネ16bの下端が固定されており、該コイルバネ16bの上端が固定された振動部材16cの下側に振動モータ16dが取り付けられている。尚、コイルバネ16b内には、取り付け部材118に下端を固定された下側ガイド部材124及び振動部材16cに上端を固定された上側ガイド部材123が互いに適度の間隔をおいて配置されている。

【0053】

図14及び図15は本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置を構成する振動流動発生部のめっき槽への取り付けの他の形態を示す断面図であり、図16はその平面図である。図14及び図15はそれぞれ図16のX-X'断面及びY-Y'断面に相当する。尚、これらの図では、めっき処理のための陰極

、陽極及び電源回路等は図示を省略されている。

【 0 0 5 4 】

この形態では、振動吸収部材として上記コイルバネ 1 6 b に代えてゴム板 2 と金属板 1, 1' との積層体 3 が用いられている。即ち、積層体 3 は、めっき槽 1 2 の上端縁部に固定された取り付け部材 1 1 8 に防振ゴム 1 1 2 を介して取り付けられた金属板 1' をボルト 1 3 1 により固定し、該金属板 1' 上にゴム板 2 を配置し、該ゴム板 2 上に金属板 1 を配置し、これらをボルト 1 1 6 及びナット 1 1 7 により一体化することで形成されている。

【 0 0 5 5 】

振動モータ 1 6 d は支持部材 1 1 5 を介してボルト 1 3 2 により金属板 1 に固定されている。また、振動伝達ロッド 1 6 e の上端部はゴムリング 1 1 9 を介して積層体 3 特に金属板 1 とゴム板 2 とに取り付けられている。即ち、上側金属板 1 は図 1 その他に記載されている実施形態の振動部材 1 6 c の機能をも発揮するものであり、下側金属板 1' は図 1 その他に記載されている実施形態の基台 1 6 a の機能をも発揮するものである。そして、これら金属板 1, 1' を含む積層体 3 (主としてゴム板 2) が図 1 その他に記載されているコイルバネ 1 6 b と同様な振動吸収機能を発揮する。

【 0 0 5 6 】

図 1 7 は積層体 3 の平面図を示す。図 1 1 ~ 1 6 の形態に対応する図 1 7 (a) の例では、積層体 3 には振動伝達ロッド 1 6 e を通すための貫通孔 5 が形成されている。また、図 1 7 (b) の例では、積層体 3 は貫通孔 5 を通る分割線により 2 分割された 2 つの部分 3 a, 3 b からなり、これによれば装置組立の際に振動伝達ロッド 1 6 e を容易に通すことができる。また、図 1 7 (c) の例では、積層体 3 は、めっき槽 1 2 の上端縁部に対応する環形状をなしており、中央部に開口 6 が形成されている。

【 0 0 5 7 】

図 1 7 (a), (b) の例では、めっき槽 1 2 の上部が積層体 3 により塞がれ、これによりめっき処理の際にめっき浴 1 4 から揮散するガスや飛散するめっき液が周囲へと漏れるのを防止することができる。

【 0 0 5 8 】

図 1 8 は、このような積層体 3 によるめっき槽上部の閉塞（シール）の様子を示す断面図である。図 1 8（a）の形態では、ゴム板 2 が貫通孔 5 において振動伝達ロッド 1 6 e に当接してシールがなされる。また、図 1 8（b）の形態では、積層体 3 の開口部 6 において該積層体 3 と振動伝達ロッド 1 6 e とに取り付けられこれらの間の空隙を塞ぐフレキシブルシール部材 1 3 6 が設けられている。

【 0 0 5 9 】

図 1 9 に振動吸収部材としての積層体 3 の例を示す。図 1 9（b）の例は上記図 1 4 ～ 1 6 の実施形態のものである。図 1 9（a）の例では、積層体 3 は金属板 1 とゴム板 2 とからなる。図 1 9（c）の例では、積層体 3 は上側金属板 1 と上側ゴム板 2 と下側金属板 1' と下側ゴム板 2' とからなる。図 1 9（d）の例では、積層体 3 は上側金属板 1 と上側ゴム板 2 と中間金属板 1'' と下側ゴム板 2' と下側金属板 1' とからなる。積層体 3 における金属板やゴム板の数は、例えば 1 ～ 5 とすることができる。尚、本発明においては、ゴム板のみから振動吸収部材を構成することも可能である。

【 0 0 6 0 】

金属板 1, 1', 1'' の材質としては、ステンレス鋼、鉄、銅、アルミニウム、その他適宜の合金を使用することができる。金属板の厚さは、例えば 1 0 ～ 4 0 mm である。但し、積層体以外の部材に対して直接固定されない金属板（例えば上記中間金属板 1''）は 0. 3 ～ 1 0 mm と薄くすることができる。

【 0 0 6 1 】

ゴム板 2, 2' の材質としては、合成ゴム又は天然ゴムの加硫物を使用することができ、J I S K 6 3 8 6 で規定される防振ゴムが好ましく、更に特に静的剪断弾性率 $4 \sim 22 \text{ kgf/cm}^2$ 好ましくは $5 \sim 10 \text{ kgf/cm}^2$ 、伸び 2 5 0 % 以上のものが好ましい。合成ゴムとしては、クロロプレンゴム、ニトリルゴム、ニトリル-クロロプレンゴム、スチレン-クロロプレンゴム、アクリロニトリル-ブタジエンゴム、イソプレンゴム、エチレン-プロピレンジエン共重合体ゴム、エピクロルヒドリン系ゴム、アルキレンオキシド系ゴム、フッ素系ゴム、シリコン系ゴム、ウレタン系ゴム、多硫化ゴム、フォスファビンゴンを例示

することができる。ゴム板の厚さは、例えば5～60mmである。

【0062】

図19(d)の例では、積層体3は上側金属板1とゴム板2と下側金属板1'ととからなり、ゴム板2が上側ソリッドゴム層2aとスポンジゴム層2bと下側ソリッドゴム層2cとからなる。下側ソリッドゴム層2a, 2cのうちの一方を除去してもよいし、更に複数のソリッドゴム層と複数のスポンジゴム層とを積層したものであってもよい。

【0063】

図20は、上記の実施形態において、電源回路34により陰極ブスバー30と陽極ブスバー32との間に印加される電圧に基づき被めっき物品Xを介して流れるめっき電流（電流密度）の変化の変形例を示すグラフである。この変形例では、第1状態及び第2状態の電流密度波形が、上記図8に示すような矩形状ではなく、若干の脈動を生じているものである。このような脈動は電源回路34の構成に基づくものであり、本発明ではめっき電流はこのような脈動電流であってもよい。第1状態及び第2状態の電流値I1, I2としては、それぞれの状態でのピーク値を用いることができる。

【0064】

尚、本発明では、電源回路34として、第1状態のための電圧供給系統と第2状態のための電圧供給系統とを備えたものを用い、これら2つの系統から交互に出力させるもの（即ち、2つの電源装置を切り替えて用いるものと等価）を用いてもよい。

【0065】

以上のようなめっき浴の振動流動とパルス状めっき電流との組み合わせの技術は、同様に処理浴内での通電を利用して被処理物の表面処理を行う陽極酸化法や電解研磨法や電解脱脂法などにも適用することができる。もちろん、処理内容に応じて被処理物は陽極側または陰極側に配置される。これにより、微細構造をもつ被処理物品の表面処理を良好に行うことが可能となる。

【0066】

【実施例】

以下、本発明を実施例により説明する。

【 0 0 6 7 】

実施例 1 :

図 1 ～ 3 に関して説明した装置を使用した。ここで、振動モータ 1 6 d として 1 5 0 W × 2 0 0 V × 3 φ のものを用い、めっき槽 1 2 として容量 3 0 0 リットルのものを用い、電源回路 3 4 として (株) 中央製作所製の P o w e r M a s t e r を用いた。

【 0 0 6 8 】

被めっき物品 X として常法により所定の前処理を施した 8 インチ (直径 2 0 0 m m) のシリコンウエハを用い、多層配線形成のための銅ダマシン法のうちの銅シード層の施されたブラインドビアホールへの銅埋め込み導電膜の形成を行った。多数のブラインドビアホールは厚さ 0 . 3 5 μ m の窒化チタン絶縁層に内径 0 . 2 4 μ m で形成されていた。

【 0 0 6 9 】

めっき浴 1 4 としては、硫酸銅めっきのスルーホール浴、

硫酸銅 : 7 5 g / L

硫酸 : 1 9 0 g / L

光沢剤 : 適量

塩素イオン : 4 0 m L / L

を用いた。

【 0 0 7 0 】

振動流動発生部 1 6 の振動モータ 1 6 d を 4 5 H z で振動させて、振動羽根 1 6 f をめっき浴 1 4 中で振幅 0 . 2 m m 及び振動数 6 5 0 回 / 分で振動させた。また、振動モータ 2 8 を 2 5 H z で振動させて、被めっき物品 X をめっき浴 1 4 中で振幅 0 . 1 5 m m 及び振動数 2 0 0 回 / 分で振動させた。この時のめっき浴中の 3 次元流速を 3 次元電磁流速計 A C M 3 0 0 - A (アレック電子株式会社製) で測定したところ 2 0 0 m m / 秒であった。

【 0 0 7 1 】

電源回路 3 4 により、図 8 に示されている I 1 , I 2 , T 1 , T 2 がそれぞれ

$I_1 = 6 [A / \text{ウエハ}] = 0.10 [A / \text{dm}^2]$, $I_2 = 0.5 [A / \text{ウエハ}]$, $T_1 = 10 [\text{秒}]$, $T_2 = 1 [\text{秒}]$ となる様に、めっき電流を流した。

【 0 0 7 2 】

3 分間処理を行ったところ、多数のブラインドビアホール of 全てについて良好な銅めっき膜の埋め込みがなされていることが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 7 3 】

比較例 1 - 1 :

$T_2 = 0 [\text{秒}]$ とすることを除いて実施例 1 と同様な処理を行ったところ、多数のブラインドビアホールの一部 (58%) には良好な銅めっき膜の埋め込みがなされているが残りには良好な銅めっき膜の埋め込みがなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 7 4 】

比較例 1 - 2 :

振動流動発生部 16 を作動させないことを除いて実施例 1 と同様な処理を行ったところ、多数のブラインドビアホールの一部 (10%) には良好な銅めっき膜の埋め込みがなされているが残りには良好な銅めっき膜の埋め込みがなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 7 5 】

実施例 2 :

図 1 ~ 3 に関して説明した装置 (振動モータ 16 d 及びめっき槽 12 及び電源回路 34 は実施例 1 と同様) を使用し、被めっき物品 X として常法により所定の前処理を施した A4 版寸法の多層配線基板を用い、スルーホール内面へのめっき導電膜の形成を行った。多数のスルーホールは内径 $30 \mu\text{m} \phi$ でアスペクト比 10 であった。

【 0 0 7 6 】

めっき浴 14 としては、硫酸銅めっきの普通浴、

硫酸銅 : 200 g / L

硫酸 : 50 g / L

光沢剤： 適量

塩素イオン： 6 0 m L / L

を用いた。

【 0 0 7 7 】

振動流動発生部 1 6 の振動モータ 1 6 d を 5 0 H z で振動させて、振動羽根 1 6 f をめっき浴 1 4 中で振幅 0 . 2 m m 及び振動数 7 0 0 回 / 分で振動させた。この時のめっき浴中の 3 次元流速を 3 次元電磁流速計 A C M 3 0 0 - A で測定したところ 2 0 0 m m / 秒であった。

【 0 0 7 8 】

電源回路 3 4 により、図 8 に示されている I_1 , I_2 , T_1 , T_2 がそれぞれ $I_1 = 4 [A / d m^2]$, $I_2 = 0 . 4 [A / d m^2]$, $T_1 = 1 8 0 [秒]$, $T_2 = 2 0 [秒]$ となる様に、めっき電流を流した。

【 0 0 7 9 】

1 0 分間処理を行ったところ、多数のスルーホールの 9 9 . 5 % について良好な銅めっき膜が形成されていることが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 8 0 】

比較例 2 - 1 :

$T_2 = 0 [秒]$ とすることを除いて実施例 2 と同様な処理を行ったところ、多数のスルーホールの一部 (5 0 %) には全長にわたって良好な銅めっき膜の形成がなされているが残りには良好な銅めっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 8 1 】

比較例 2 - 2 :

振動流動発生部 1 6 を作動させないことを除いて実施例 2 と同様な処理を行ったところ、多数のスルーホールの一部 (1 0 %) には良好な銅めっき膜の形成がなされているが残りには良好な銅めっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 8 2 】

実施例 3 :

図 9 ～ 1 1 に関して説明した装置（振動モータ 1 6 d 及びめっき槽 1 2 及び電源回路 3 4 は実施例 1 と同様）を使用し、被めっき物品 X として常法により所定の前処理を施した寸法 0. 6 mm × 0. 3 mm × 0. 2 mm のセラミックチップを 8 0 0 個用い、その長手方向に関する両端の面及びこれに続く 0. 6 mm × 0. 3 mm の面の一部（両端面から 0. 1 mm までの領域）に電極膜形成のためのニッケルめっき膜の形成及びその上のスズめっき膜の形成を行った。

【 0 0 8 3 】

ニッケルめっきの際のめっき浴 1 4 としては、バレル浴

硫酸ニッケル： 2 7 0 g / L

塩化ニッケル： 6 8 g / L

ほう酸： 4 0 g / L

硫酸マグネシウム： 2 2 5 g / L

を用いた。

【 0 0 8 4 】

振動流動発生部 1 6 の振動モータ 1 6 d を 5 5 H z で振動させて、振動羽根 1 6 f をめっき浴 1 4 中で振幅 0. 2 mm 及び振動数 7 5 0 回 / 分で振動させた。この時のめっき浴中の 3 次元流速を 3 次元電磁流速計 A C M 3 0 0 - A で測定したところ 2 1 0 mm / 秒であった。バレル 5 2 としてメッシュ開口率 2 0 % のものを使用し、バレル回転数を 1 0 r p m とした。

【 0 0 8 5 】

電源回路 3 4 により、図 8 に示されている I_1 , I_2 , T_1 , T_2 をそれぞれ $I_1 = 4 [A / d m^2]$, $I_2 = 0. 4 [A / d m^2]$, $T_1 = 2 0 [秒]$, $T_2 = 2 [秒]$ となる様に、めっき電流を流した。

【 0 0 8 6 】

5 0 ° C で 1 0 分間の処理を行ったところ、チップの全てについて良好なニッケルめっき膜が形成されていることが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 8 7 】

比較例 3-1 :

$T2 = 0$ [秒] とすることを除いて実施例 3 と同様な処理を行ったところ、チップの一部 (12%) には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0088】

比較例 3-2 :

振動流動発生部 16 を作動させないことを除いて実施例 3 と同様な処理を行ったところ、多数のスルーホールの一部 (60%) には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0089】

実施例 4 :

実施例 3 と同様にして、ニッケルめっきの代わりにスズめっきを行った。めっき浴 14 としては、酸性スズめっきの硫酸塩浴、

硫酸第一スズ:	50 g/L
硫酸:	100 g/L
クレゾールスルホン酸:	100 g/L
ゼラチン:	2 g/L
β -ナフトール:	1 g/L

を用いた。

【0090】

電源回路 34 により、図 8 に示されている $I1$, $I2$, $T1$, $T2$ をそれぞれ $I1 = 0.04$ [A/dm²], $I2 = 0.004$ [A/dm²], $T1 = 20$ [秒], $T2 = 2$ [秒] となる様に、めっき電流を流した。

【0091】

50℃で20分間の処理を行ったところ、チップの全てについて良好なスズめっき膜が形成されていることが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0092】

比較例 4 - 1 :

T 2 = 0 [秒] とすることを除いて実施例 4 と同様な処理を行ったところ、チップの一部 (1 0 %) には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 9 3 】

比較例 4 - 2 :

振動流動発生部 1 6 を作動させないことを除いて実施例 3 と同様な処理を行ったところ、多数のスルーホールの一部 (5 7 %) には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【 0 0 9 4 】

実施例 5 :

図 9 ~ 1 1 に関して説明した装置 (振動モータ 1 6 d 及びめっき槽 1 2 及び電源回路 3 4 は実施例 1 と同様) を使用し、被めっき物品 X として常法により所定の前処理を施した外形 0. 5 mm ϕ で長さ 2 0 mm のしんちゅうピンを 3 0 個用い、その外面にニッケルめっき膜の形成を行った。

【 0 0 9 5 】

ニッケルめっきの際のめっき浴 1 4 としては、バレル浴

硫酸ニッケル： 2 7 0 g / L

塩化ニッケル： 6 8 g / L

ほう酸： 4 0 g / L

硫酸マグネシウム： 2 2 5 g / L

を用いた。

【 0 0 9 6 】

振動流動発生部 1 6 の振動モータ 1 6 d を 4 5 H z で振動させて、振動羽根 1 6 f をめっき浴 1 4 中で振幅 0. 2 mm 及び振動数 5 0 0 回 / 分で振動させた。この時のめっき浴中の 3 次元流速を 3 次元電磁流速計 ACM 3 0 0 - A で測定したところ 2 0 0 mm / 秒であった。バレル 5 2 としてメッシュ開口率 2 0 % のも

のを使用し、バレル回転数を10rpmとした。

【0097】

電源回路34により、図8に示されているI1, I2, T1, T2をそれぞれ $I1 = 3 [A/dm^2]$, $I2 = 0.3 [A/dm^2]$, $T1 = 30 [秒]$, $T2 = 3 [秒]$ となる様に、めっき電流を流した。

【0098】

50℃で20分間処理を行ったところ、ピンの全てについて良好なニッケルめっき膜が形成されていることが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0099】

比較例5-1:

$T2 = 0 [秒]$ とすることを除いて実施例5と同様な処理を行ったところ、ピンの一部(17%)には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0100】

比較例5-2:

振動流動発生部16を作動させないことを除いて実施例5と同様な処理を行ったところ、ピンの一部(60%)には良好なニッケルめっき膜の形成がなされているが残りには良好なニッケルめっき膜の形成がなされていないことが、通電、顕微鏡その他の検査の結果判明した。

【0101】

【発明の効果】

以上説明した様に、本発明の電解めっき方法によれば、めっき膜導電パターンが微細であっても、欠陥や膜厚不均一性などがなく良好な品質でめっき膜を形成することが可能である。また、本発明によれば、微細構造の導電パターンの良好な品質のめっき膜を高速に得ることが可能である。更に、本発明によれば、微細構造の導電パターンの良好な品質のめっき膜を比較的小さな装置構成で効率よく得ることが可能である。

【図面の簡単な説明】

【図 1】

本発明によるめっき方法の第 1 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図である。

【図 2】

本発明によるめっき方法の第 1 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図である。

【図 3】

本発明によるめっき方法の第 1 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す平面図である。

【図 4】

振動部材への振動伝達ロッドの取り付け部の拡大断面図である。

【図 5】

振動伝達ロッドへの振動羽根の取り付け部の拡大断面図である。

【図 6】

振動伝達ロッドへの振動羽根の取り付け部の変形例を示す図である。

【図 7】

被めっき物品の陰極ブスバーへの取り付けの変形例を示す断面図である。

【図 8】

被めっき物品を介して流れるめっき電流の変化を示すグラフである。

【図 9】

本発明によるめっき方法の第 2 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図である。

【図 1 0】

本発明によるめっき方法の第 2 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す断面図である。

【図 1 1】

本発明によるめっき方法の第 2 の実施形態の実施されるめっき装置の構成を示す平面図である。

【図 1 2】

本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置を示す断面図である。

【図 1 3】

図 1 2 のめっき装置の一部切欠平面図である。

【図 1 4】

本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置を構成する振動流動発生部のめっき槽への取り付けを示す断面図である。

【図 1 5】

本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置を構成する振動流動発生部のめっき槽への取り付けを示す断面図である。

【図 1 6】

本発明によるめっき方法の実施に使用されるめっき装置を構成する振動流動発生部のめっき槽への取り付けを示す平面図である。

【図 1 7】

積層体の平面図である。

【図 1 8】

積層体によるめっき槽上部の閉塞の様子を示す断面図である。

【図 1 9】

積層体を示す図である。

【図 2 0】

被めっき物品を介して流れるめっき電流の変化を示すグラフである。

【符号の説明】

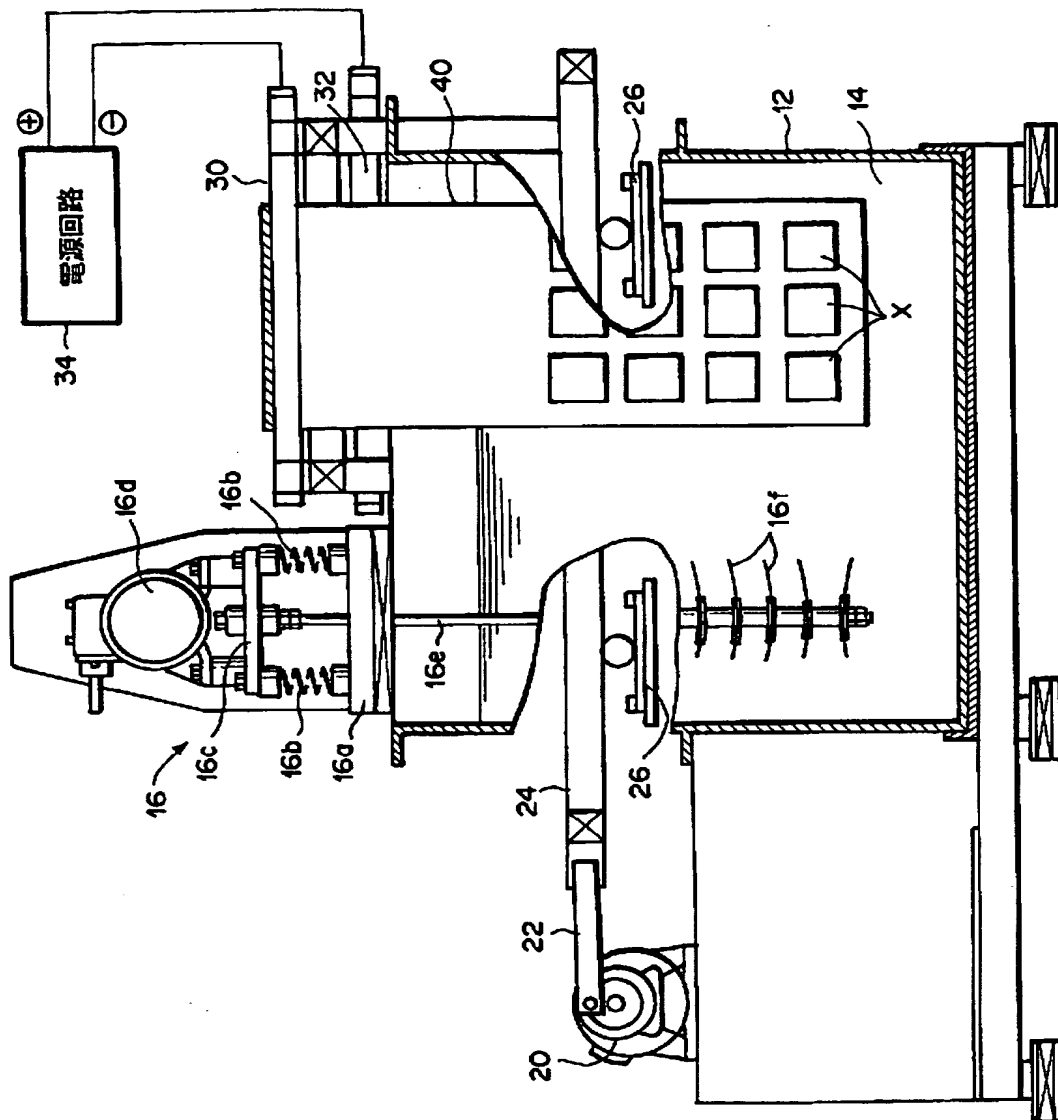
- 1, 1', 1" 金属板
- 2, 2' ゴム板
- 2 a, 2 c ソリッドゴム層
- 2 b スポンジゴム層
- 3 積層体
- 5 貫通孔
- 6 開口
- 1 2 めっき槽

- 1 4 めっき浴
- 1 6 振動流動発生部
- 1 6 a 基台
- 1 6 b コイルバネ
- 1 6 c 振動部材
- 1 6 d 振動モータ
- 1 6 e 振動伝達ロッド
- 1 6 f 振動羽根
- 1 6 g 1, 1 6 g 2 振動応力分散部材
- 1 6 h 1, 1 6 h 2 ワッシャ
- 1 6 i 1, 1 6 i 2 ; 1 6 i 3, 1 6 i 4 ナット
- 1 6 j 振動羽根固定部材
- 1 6 k スペーサリング
- 1 6 m, 1 6 n ナット
- 1 6 p 弾性部材シート
- 2 0 揺動モータ
- 2 2 連結ロッド
- 2 4 揺動フレーム
- 2 6 レール
- 2 8 振動モータ
- 3 0 陰極ブスバー
- 3 2 陽極ブスバー
- 3 4 電源回路
- 4 0 被めっき物品保持部材
- 4 0 a 上部フック部
- 4 0 b 下部クランプ部
- 4 0 c 圧縮バネ
- 4 4 振動フレーム
- 4 6 コイルバネ

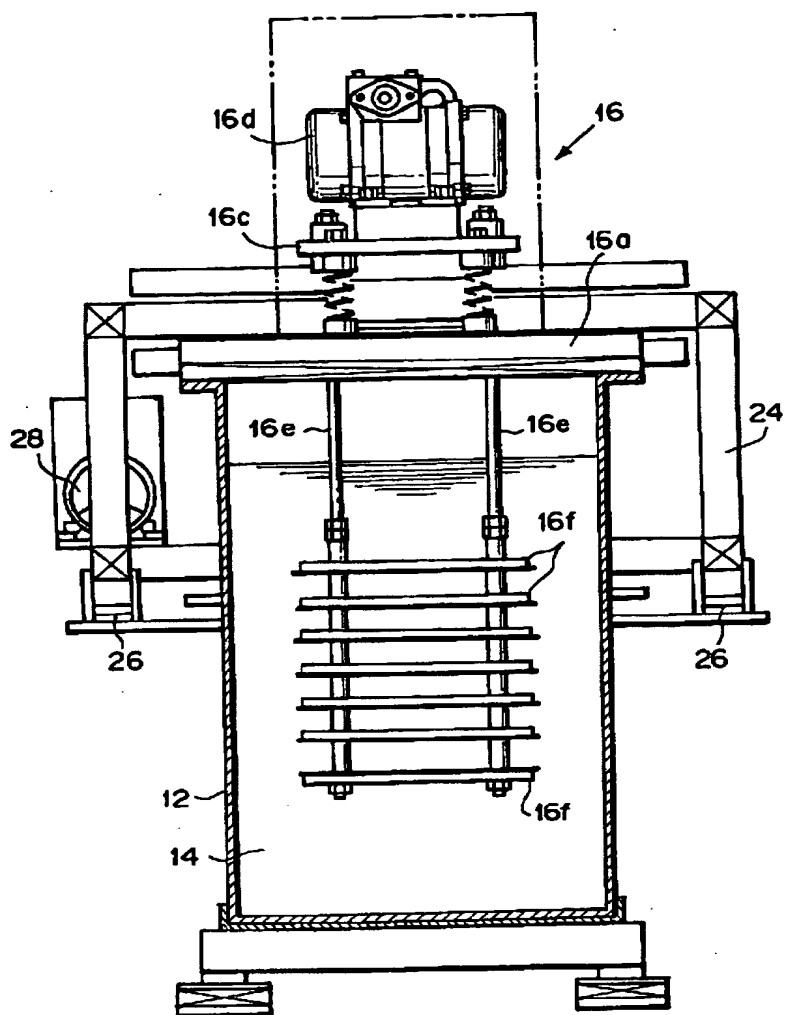
- 4 8 振動モータ
- 4 9 バランスウェイト
- 5 0 バレル支持部材
- 5 2 バレル
- 5 2 a パイプ部材
- 5 4 陰極導電部材
- 5 6 陽極金属部材
- 1 1 2 防振ゴム
- 1 1 6 ボルト
- 1 1 7 ナット
- 1 1 8 取り付け部材
- 1 1 9 ゴムリング
- 1 2 3 上側ガイド部材
- 1 2 4 下側ガイド部材
- 1 3 1, 1 3 2 ボルト
- 1 3 6 フレキシブルシール部材
- X 被めっき物品

【書類名】 図面

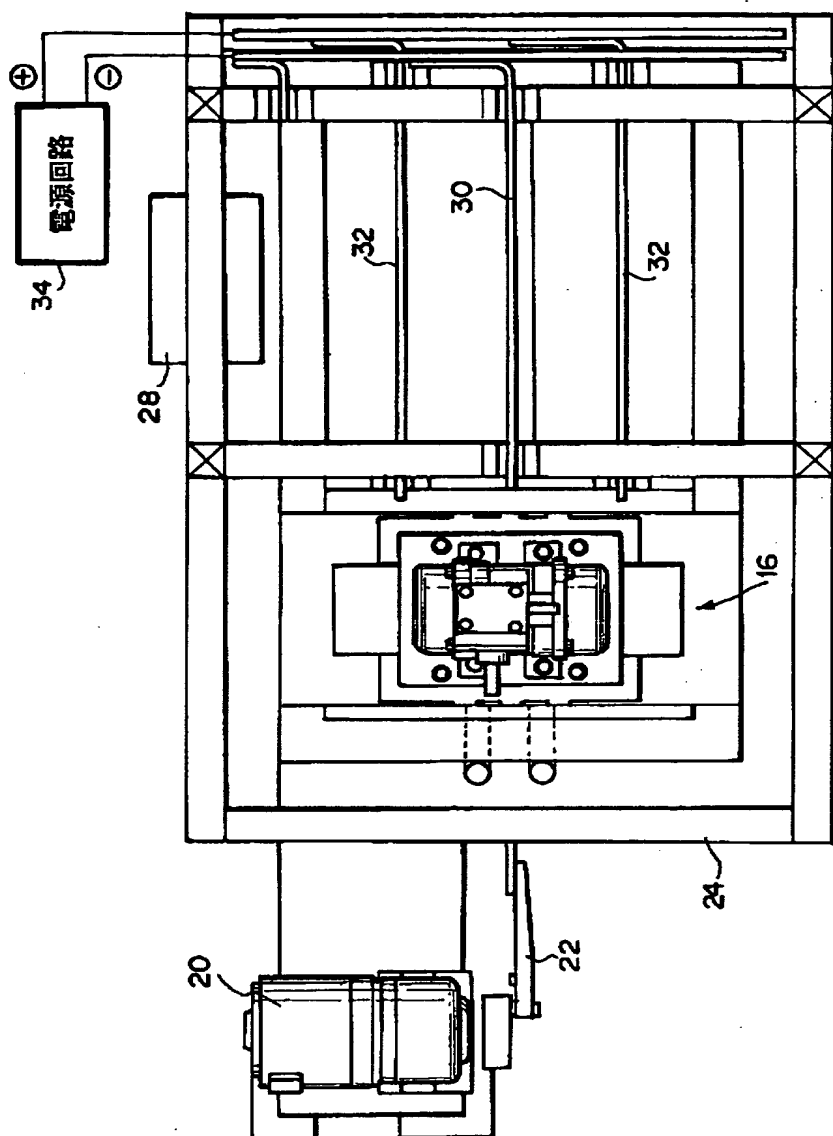
【図 1】



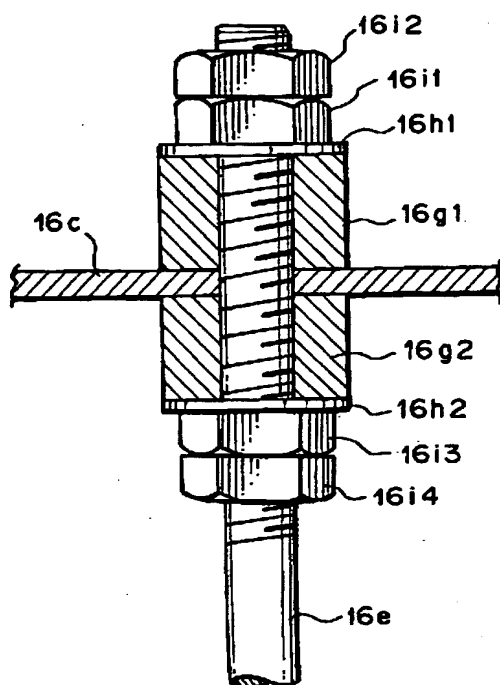
【図 2】



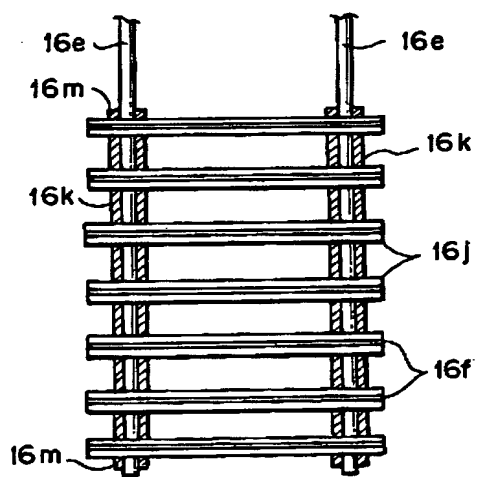
【図 3】



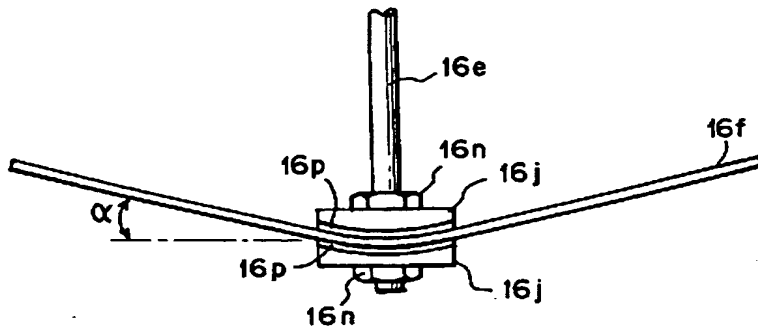
【図 4】



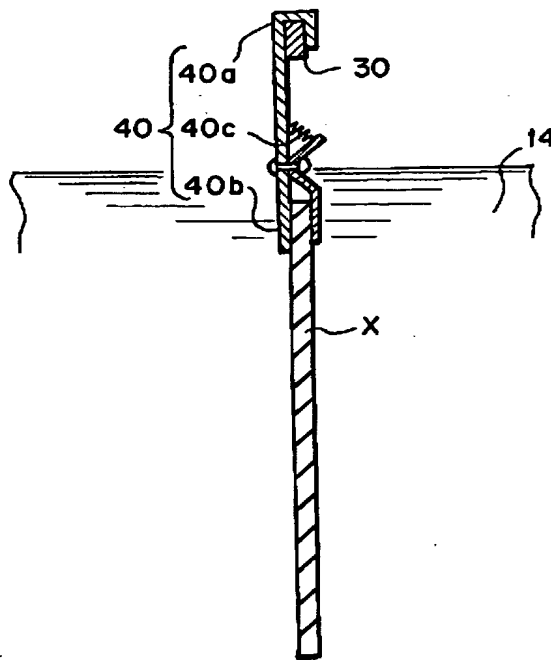
【図 5】



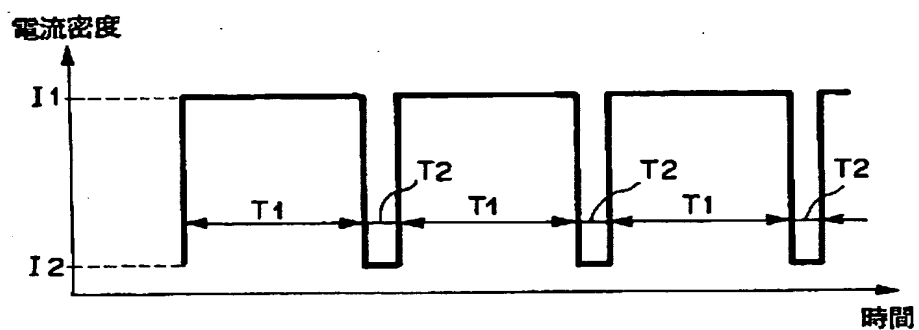
【図 6】



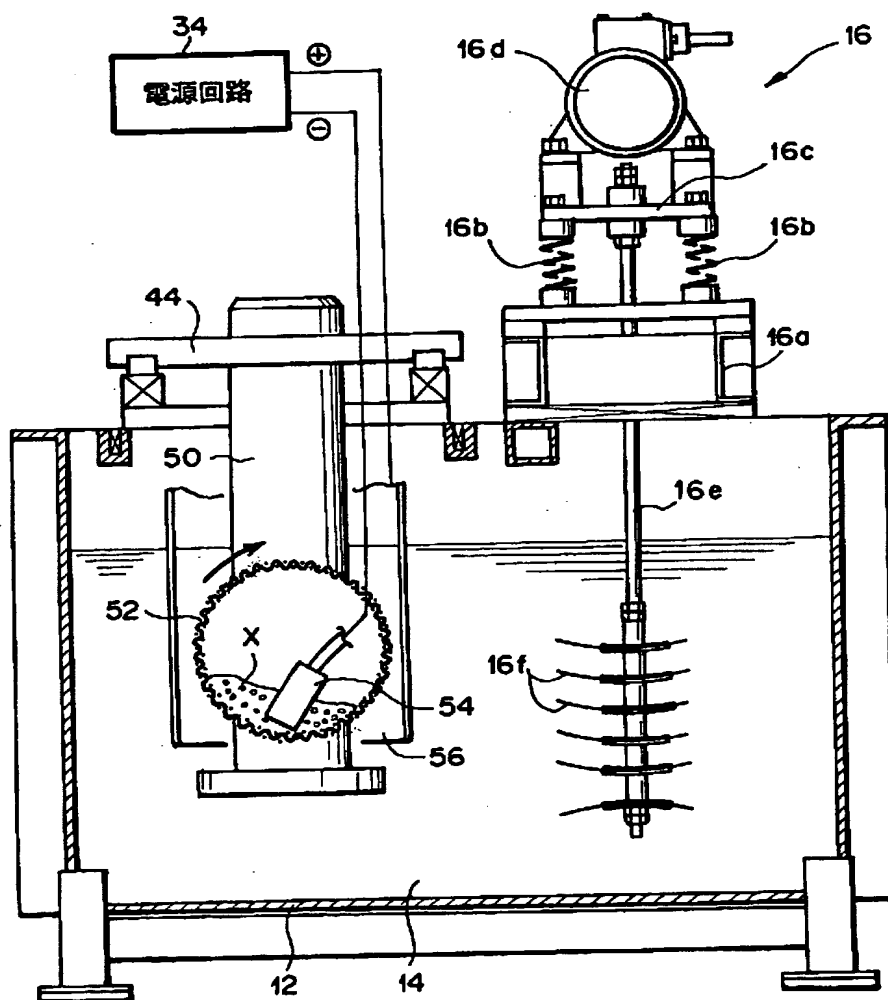
【図 7】



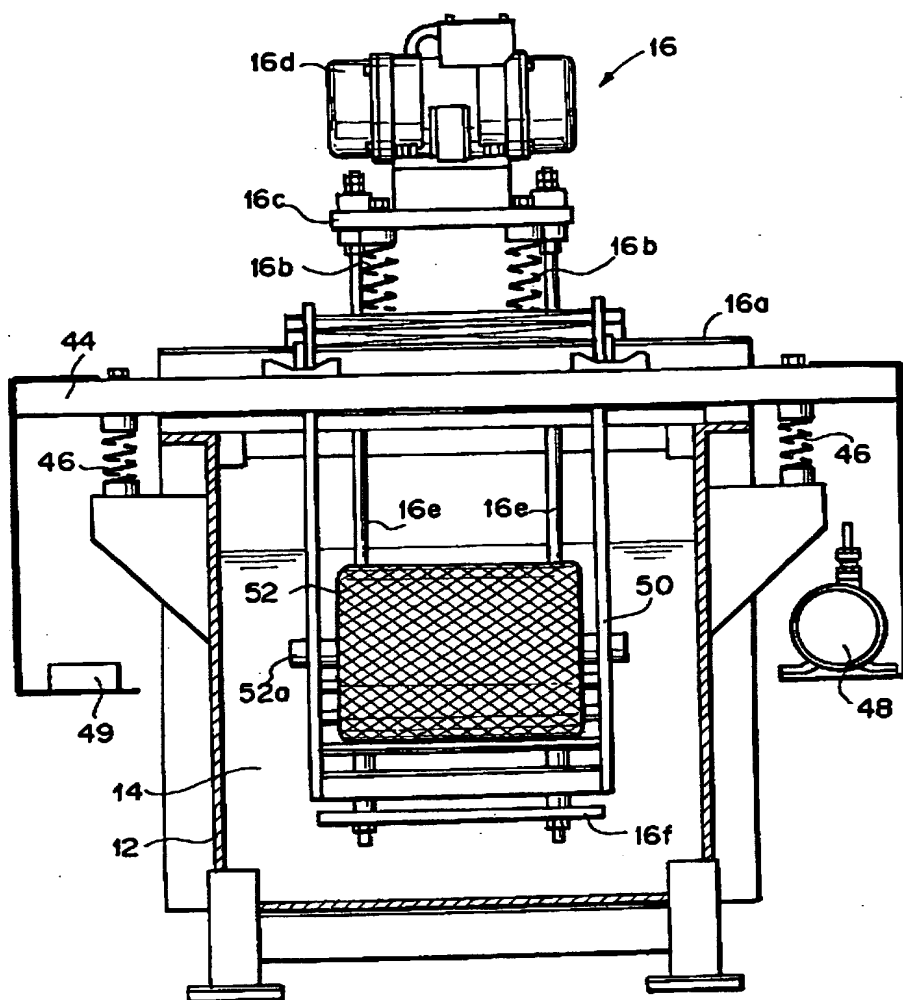
【図 8】



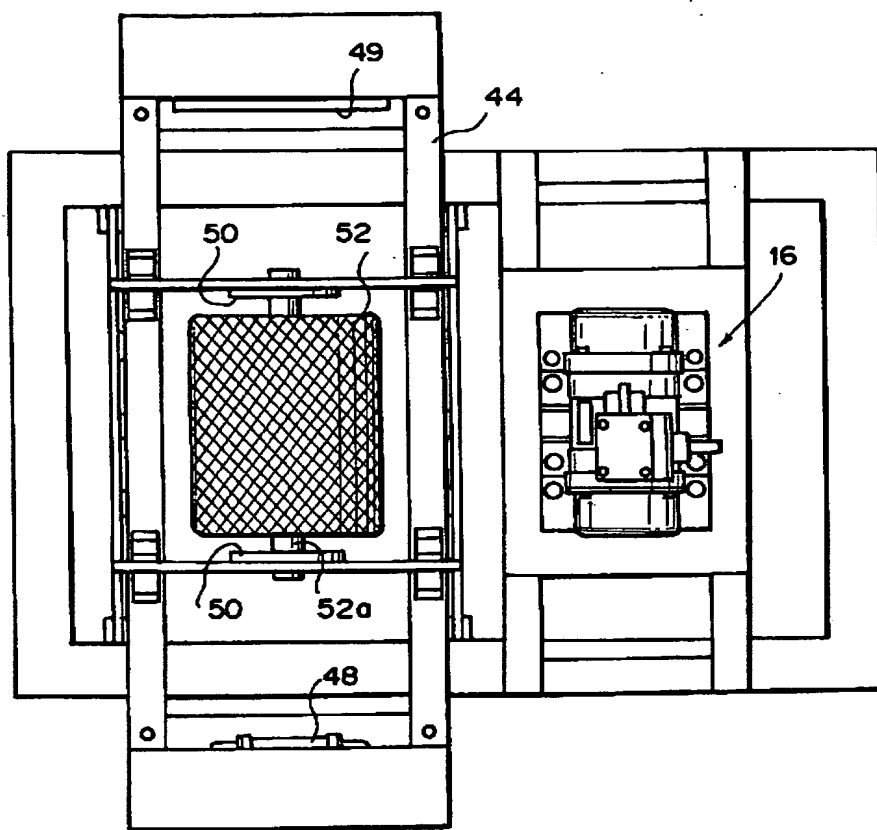
【図 9】



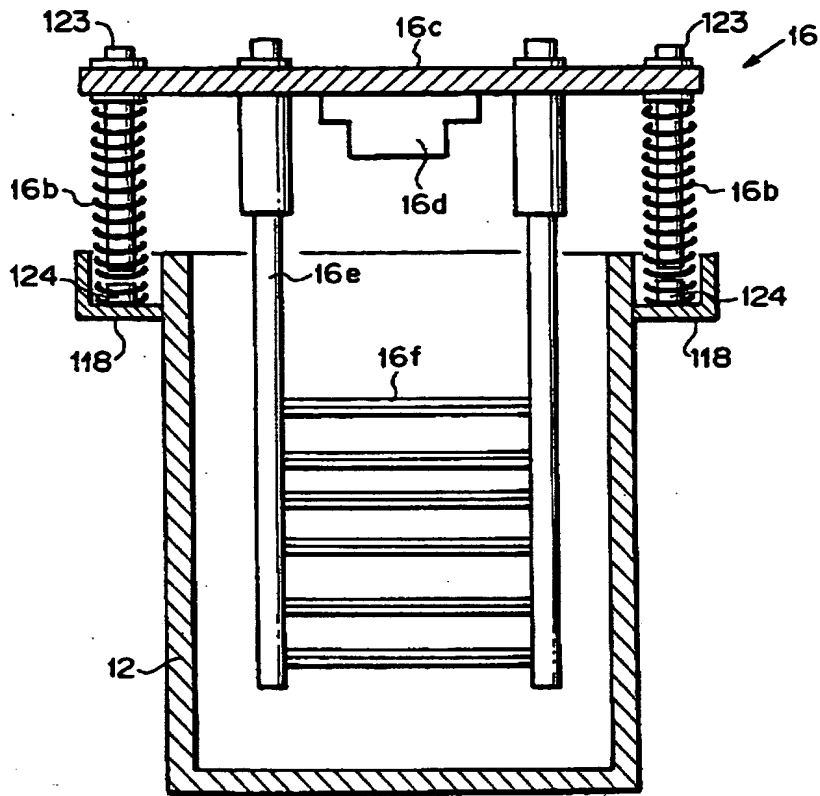
【図 10】



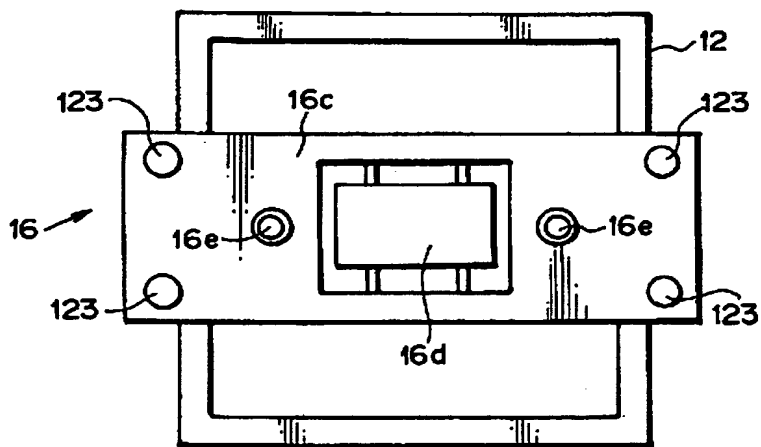
【図 11】



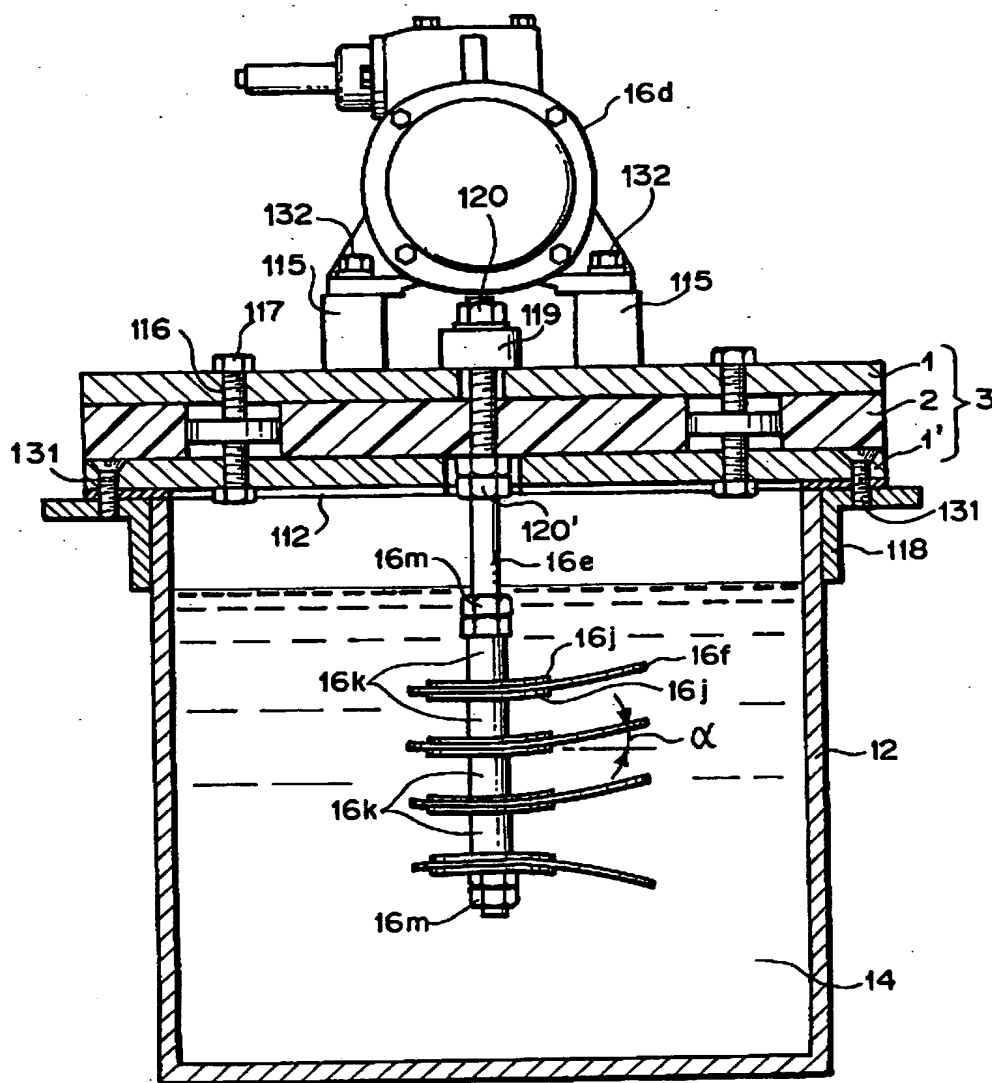
【図 1 2】



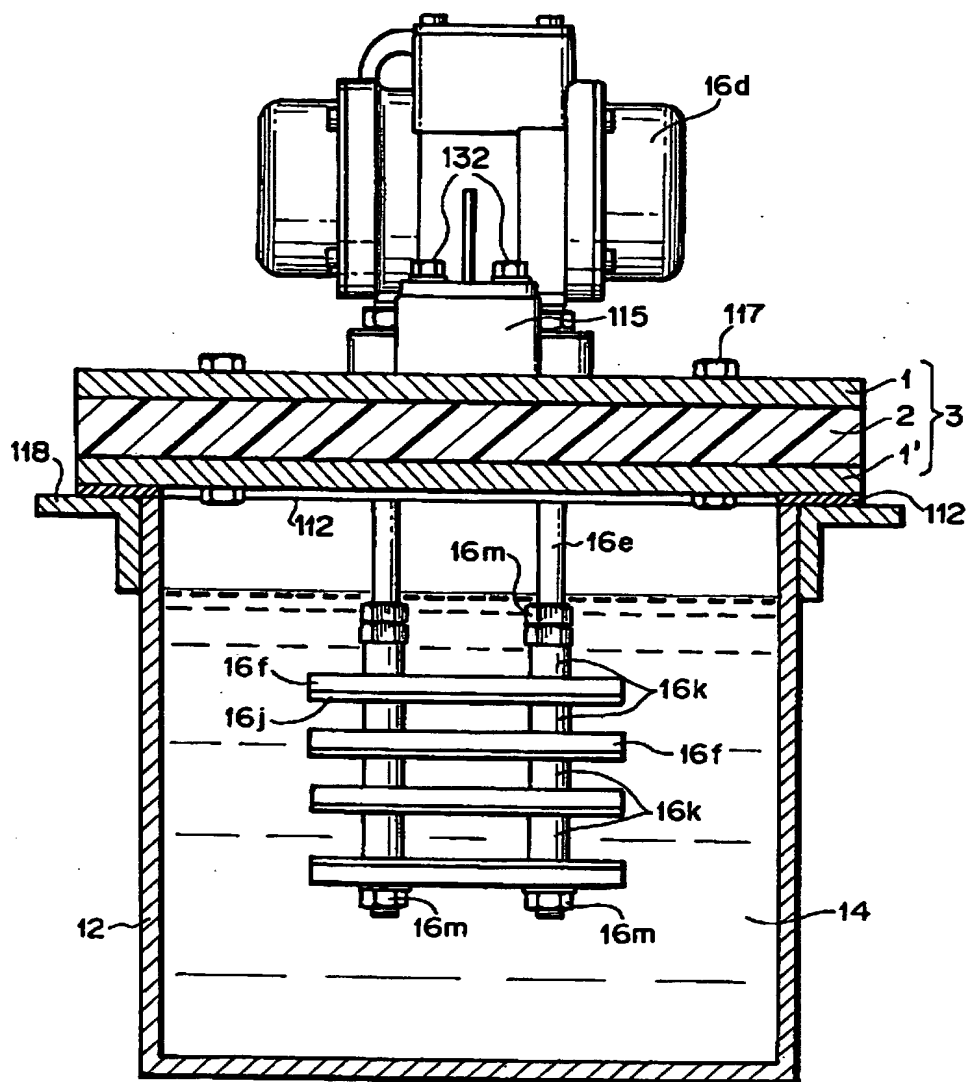
【図 1 3】



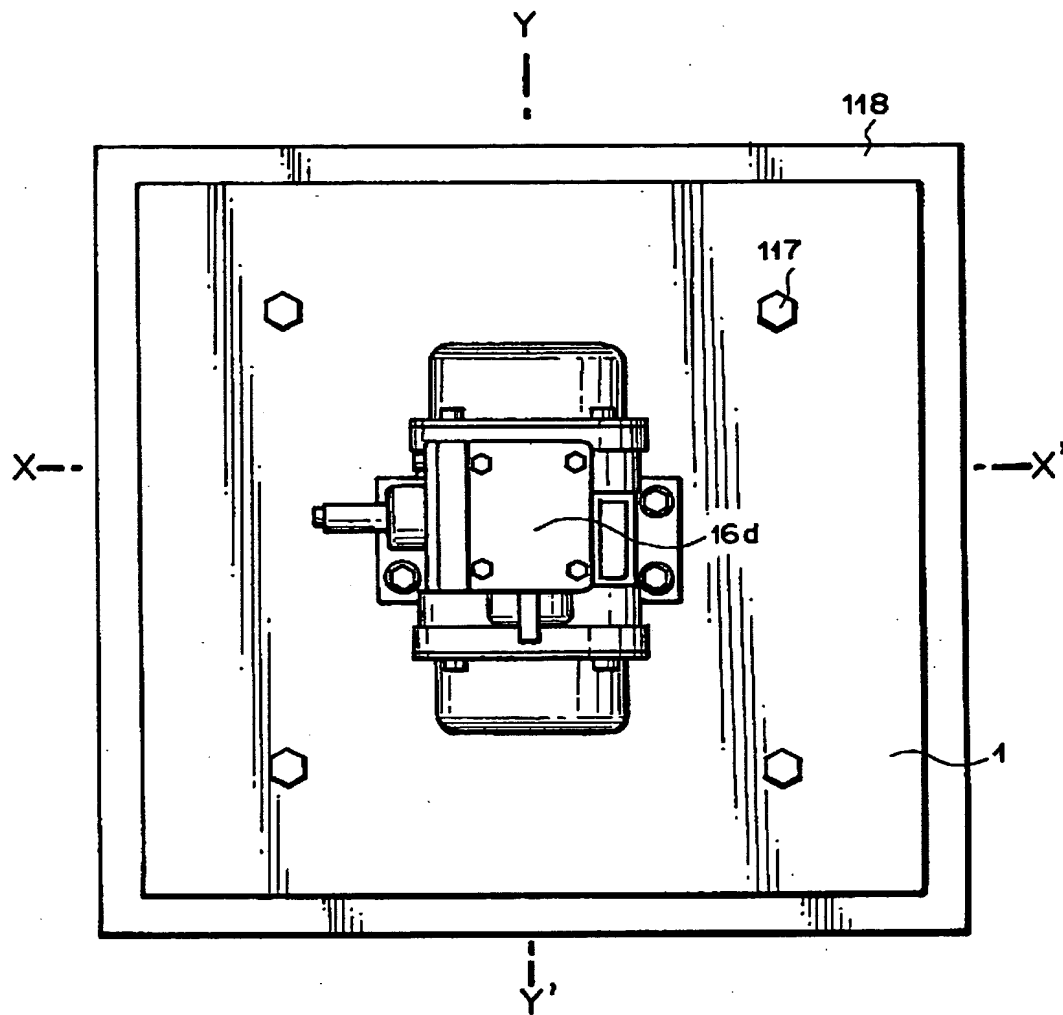
【図 14】



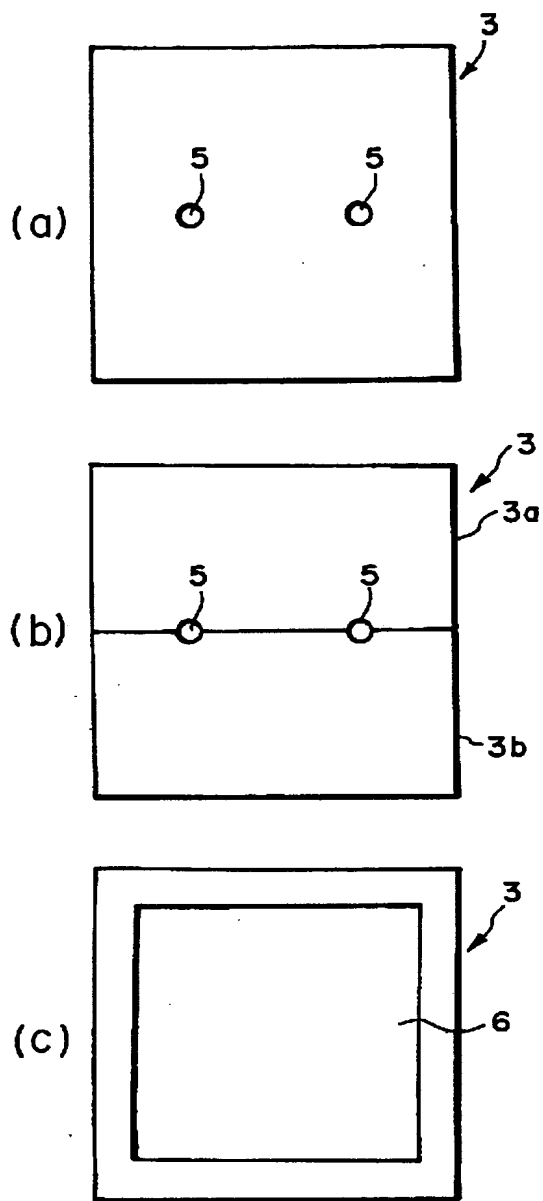
【図15】



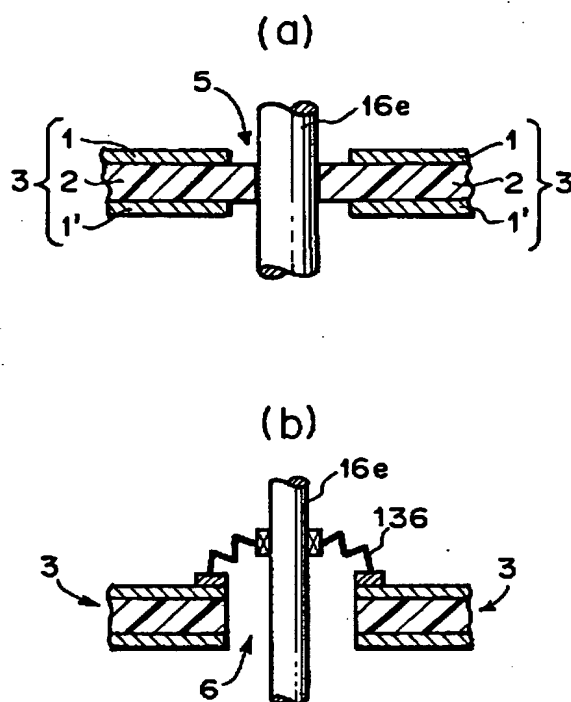
【図 16】



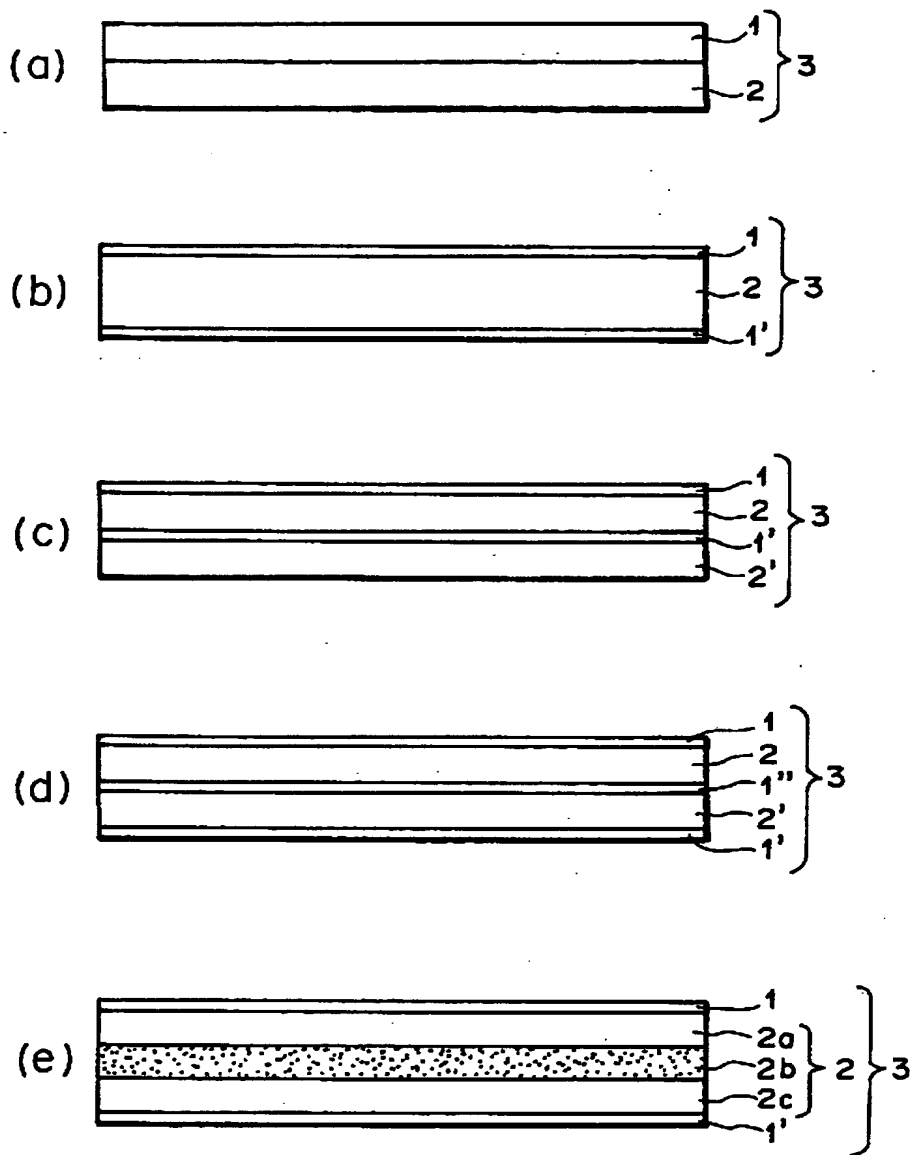
【図 1 7】



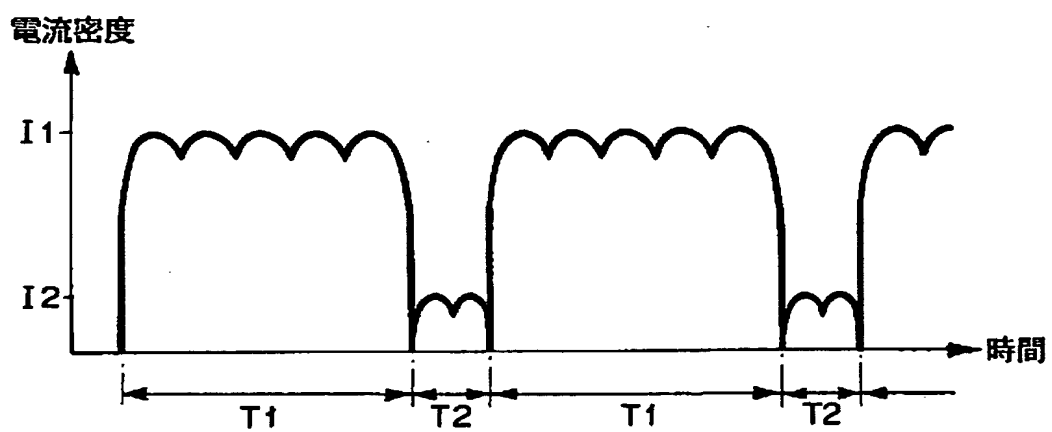
【図 1 8】



【図 1 9】



【図 2 0】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 微細構造の導電パターンのめっき膜を欠陥や膜厚不均一性などがなく良好な品質で効率よく高速に形成できるめっき方法を提供する。

【解決手段】 めっき浴 1 4 内に配置された振動羽根 1 6 f を振幅 0 . 1 ~ 1 0 . 0 m m 及び振動数 2 0 0 ~ 8 0 0 回 / 分で振動させることによりめっき浴 1 4 に 3 次元流速 1 5 0 m m / 秒以上の振動流動を発生させながら、めっき浴 1 4 中に配置された微細構造を持つ被めっき物品 X を陰極とし且つめっき浴 1 4 中に配置された金属部材 5 6 を陽極とし、陰極と陽極との間に電圧を印加し、この際に陽極からめっき浴 1 4 を介して陰極へと流れるめっき電流が第 1 の値 I 1 で第 1 の時間 T 1 持続する第 1 状態及び第 1 の値と同一極性の第 2 の値 I 2 で第 2 の時間 T 2 持続する第 2 状態を交互にとり、第 1 の値 I 1 は第 2 の値 I 2 の 6 倍以上であり、第 1 の時間 T 1 は第 2 の時間 T 2 の 4 倍以上である。

【選択図】 図 1

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号 [392026224]

1. 変更年月日 1999年11月17日

[変更理由] 住所変更

住 所 東京都大田区久が原2丁目14番10号

氏 名 日本テクノ株式会社